

(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉRATION
EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

(19) Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle
Bureau international



(43) Date de la publication internationale
6 mai 2005 (06.05.2005)

PCT

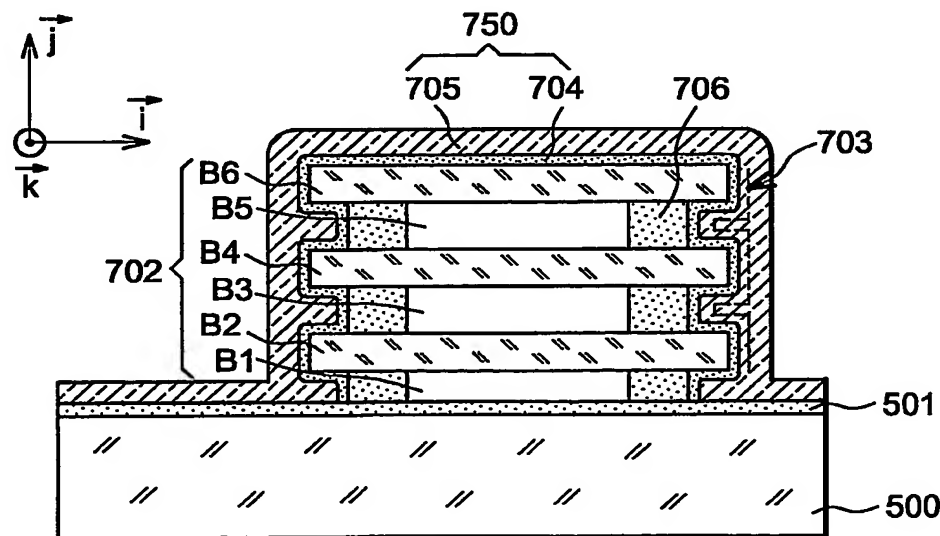
(10) Numéro de publication internationale
WO 2005/041309 A1

- (51) Classification internationale des brevets⁷ :
H01L 29/786, 29/423
- (21) Numéro de la demande internationale :
PCT/FR2004/050524
- (22) Date de dépôt international :
21 octobre 2004 (21.10.2004)
- (25) Langue de dépôt : français
- (26) Langue de publication : français
- (30) Données relatives à la priorité :
03 50716 22 octobre 2003 (22.10.2003) FR
- (71) Déposant (pour tous les États désignés sauf US) : COM-
MISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE [FR/FR];
31-33 rue de la Fédération, F-75752 PARIS 15ème (FR).
- (72) Inventeurs; et
(75) Inventeurs/Déposants (pour US seulement) : ERNST,
Thomas [FR/FR]; 703 route de Moirans, F-38140
CHARNECLES (FR). BOREL, Stephan [FR/FR]; 4 rue
de la Distillerie, F-38400 SAINT MARTIN D'HERES
(FR).
- (74) Mandataire : POULIN, Gérard; BREVATOME, 3, rue
du Docteur Lancereaux, F-75008 PARIS (FR).
- (81) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de
protection nationale disponible) : AE, AG, AL, AM, AT,
AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO,
CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB,
GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG,
KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG,
MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH,

[Suite sur la page suivante]

(54) Title: FIELD-EFFECT MICROELECTRONIC DEVICE, CAPABLE OF FORMING ONE OR SEVERAL TRANSISTOR CHANNELS

(54) Titre : DISPOSITIF MICROELECTRONIQUE A EFFET DE CHAMP APTE A FORMER UN OU PLUSIEURS CANAUX DE TRANSISTORS



(57) Abstract: The invention relates to a field-effect microelectronic device and the production method thereof. Said device comprises a substrate (700) and at least one improved structure (702), capable of forming one or several transistor channels. Said structure, composed of several bars stacked on the substrate, may allow space saving in the integration of field-effect transistors and the performances thereof to be improved.

[Suite sur la page suivante]

WO 2005/041309 A1



PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

- (84) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de protection régionale disponible) : ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasién (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), européen (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Publiée :

- avec rapport de recherche internationale
- avant l'expiration du délai prévu pour la modification des revendications, sera republiée si des modifications sont reçues

En ce qui concerne les codes à deux lettres et autres abréviations, se référer aux "Notes explicatives relatives aux codes et abréviations" figurant au début de chaque numéro ordinaire de la Gazette du PCT.

(57) **Abrége :** L'invention concerne un dispositif microélectronique à effet de champ, ainsi que son procédé de réalisation. Le dispositif comprend un substrat (700) ainsi qu'au moins une structure améliorée (702) apte à former un ou plusieurs canaux de transistors. Cette structure, bâtie de plusieurs barreaux empilés sur le substrat, peut permettre un gain de place dans l'intégration des transistors à effet de champ ainsi que d'améliorer leurs performances.